

	<h2 style="color: red;">JAN1N5552US</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	JAN1N5552US
	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 600V 3A B-MELF
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 JAN1N5552US.pdf
	RoHs Status:	Enthält Blei / RoHS nicht konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS









Spezifikationen

Teilenummer	JAN1N5552US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 600V 3A B-MELF
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.2V @ 9A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	600V
Supplier Device-Gehäuse	D-5B
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/420
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	2µs
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, B
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	1µA @ 600V
Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	-

JAN1N5552US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N5552US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N5552US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JAN1N5552US E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>JAN1N5553US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 3A B-MELF</p>	 <p>JAN1N5552 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 3A AXIAL</p>	 <p>JAN1N5554 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1KV 3A AXIAL</p>	 <p>JAN1N5551US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 3A B-MELF</p>
 <p>JAN1N5553 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 3A AXIAL</p>	 <p>JAN1N5554US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1KV 5A D5B</p>	 <p>JAN1N5552US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 3A B-MELF</p>	 <p>JAN1N5551 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 3A AXIAL</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N5552US Microsemi	JAN1N5552US Datenblatt	JAN1N5552US-Datenblätter	JAN1N5552US PDF	Microsemi JAN1N5552US
JAN1N5552US Electronic	JAN1N5552US-Komponenten	JAN1N5552US-Verteiler	JAN1N5552US-Bild	JAN1N5552US-Teil
JAN1N5552US Preis	JAN1N5552US Hersteller	JAN1N5552US Bild	JAN1N5552US Aktie	JAN1N5552US Inventar
JAN1N5552US Neu	JAN1N5552US Original	JAN1N5552US garantiert	JAN1N5552US RFQ	JAN1N5552US Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited